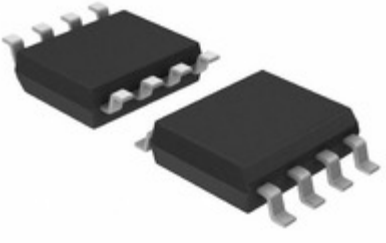

	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4842BDY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 28A 8-SOIC</p>
	<p>Datenblätter:  SI4842BDY-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI4842BDY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 28A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.2 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 6.25W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4842BDY-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3650pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 28A (Tc) 3W (Ta), 6.25W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	28A (Tc)

SI4842BDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4842BDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4842BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4842BDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4842BDY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 28A 8-SOIC</p>	 <p>SI4842 SILICONIX SI4842 SILICONIX</p>	 <p>SI4840DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 10A 8-SOIC</p>	 <p>SI4842BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 28A 8-SOIC</p>
 <p>SI4842BDY VISHAY SI4842BDY VISHAY</p>	 <p>SI4842BDY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 28A 8-SOIC</p>	 <p>SI4842DY VISHAY SI4842DY VISHAY</p>	 <p>SI4842DY-T1-E3 VISHAY SI4842DY-T1-E3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4842BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4842BDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4842BDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4842BDY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI4842BDY-T1-GE3 Electronic	SI4842BDY-T1-GE3-Komponenten	SI4842BDY-T1-GE3-Verteiler	SI4842BDY-T1-GE3-Bild	SI4842BDY-T1-GE3
SI4842BDY-T1-GE3 Preis	SI4842BDY-T1-GE3 Hersteller	SI4842BDY-T1-GE3 Bild	SI4842BDY-T1-GE3 Aktie	SI4842BDY-T1-GE3-Teil
SI4842BDY-T1-GE3 Neu	SI4842BDY-T1-GE3 Original	SI4842BDY-T1-GE3 garantiert	SI4842BDY-T1-GE3 RFQ	SI4842BDY-T1-GE3 Inventar
				SI4842BDY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited